



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



بررسی اثر حضور لایه‌های نقص در بلورهای فوتونی غیرخطی یک بعدی با استفاده از معادلات مد کوپل

محمد آقایی و داود حبری

گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران

گروه فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، زنجان، ایران

چکیده - در این مقاله با استفاده از مدل‌بندی ریاضی و شبیه‌سازی عددی به مطالعه تئوری انتشار نور همدوس در بلور فوتونی یک بعدی شامل لایه‌های نقص پرداخته شده است. برای این منظور معادلات مد کوپل برای ساختار نوری جدید بدست آمده و در حالت مانا حل شده است. با مدیریت لایه‌های نقص از نظر تعداد و مکان لایه‌ها در داخل ساختار نوری تناوبی تغییرات چشمگیری بر روی منحنی تراکسیل مشاهده شده است.

کلید واژه - بلور فوتونی غیر خطی یک بعدی، معادلات مد کوپل، لایه‌های نقص

Investigation on the effect of defect layers in 1D nonlinear photonic crystals by using coupled mode equations

Mohammad Aghaie, Davud Hebri

Department of Physics, Azarbaijan University of Tarbiat Moallem, Tabriz, Iran

Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, P. O. Box 45195-159, Zanjan 45195, Iran

Abstract- In this paper, by using mathematical modeling and detailed numerical simulations, we investigate the input-output transmission regimes in one-dimensional (1D) nonlinear photonic crystal including array defect layers. A coupled-mode system is derived from the Maxwell equations and analyzed for the stationary-transmission regime in the new proposed structure. By management in position and number of defects embedded into a periodic structure we see noticeable changes in transmission curves.

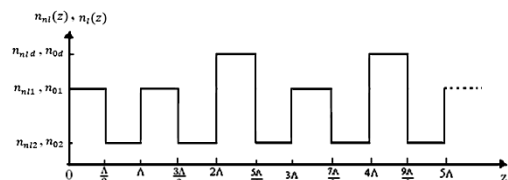
Keywords: 1D nonlinear photonic crystal, coupled mode equation, defect layers

۱- مقدمه

بلورهای فوتونی با ساختار تناوبی از دی الکتریک های با ضریب شکست های متفاوت و خواص جالب و منحصر به فردشان، توجه محققان زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. محققین انتشار نور در ساختارهای نوری تناوبی غیر خطی یک بعدی را که دارای تغییرات تناوبی در ضریب شکست خطی و غیر خطی کر هستند را اغلب با استفاده از مجموعه معادلات غیر خطی مد کوپل (CMES) [۴-۱] مورد مطالعه قرار می دهند. همچنین معرفی نقص ها در بلورهای فوتونی روشی برای کنترل مشخصه های نوری بلورهای فوتونی می باشد. در این مقاله اثر نقص ها روی خواص نوری بلور فوتونی یک بعدی با استفاده از مجموعه معادلات غیر خطی مد کوپل (CMES) مورد بررسی قرار داده شده است که با اعمال لایه های نقص پدیده هایی از قبیل دوپایایی و چندپایایی نوری مشاهده شده است.

۲- مدل بندی ریاضی مسئله

در اینجا انتشار نور همدوس در راستای z ساختار نوری پیشنهاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. ساختار نوری مرکب از لایه های یک در میان با ضریب شکست های خطی و غیر خطی کر متفاوت است که چندین لایه نقص با ضریب شکست های خطی و غیر خطی کر یکسان با فواصل مشخص از یکدیگر در داخل ساختار قرار دارد، شکل ۱ پروفایل ضریب شکست ساختار نوری معرفی شده را نشان می دهد. ضریب شکست های خطی و غیر خطی کر مربوط به هر لایه با n_{01}, n_{02} و n_{11}, n_{12} و همچنین ضریب شکست خطی و غیرخطی کر در لایه های نقص با n_{0d}, n_{1d} نشان داده شده است.



شکل ۱: پروفایل ضریب شکست خطی و غیرخطی کر ساختار نوری

ما معادله موج ماکسول غیرخطی یک بعدی را برای میدان الکتریکی داخل ساختار غیر خطی تناوبی که بوسیله لایه های نقص اشغال شده است را مطالعه می کنیم [۵].

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{n^2(z, |E|^2)}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

که در آن فرض شده است،

$$\left\| n^2(z, |E|^2) \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \right\| \gg \left\| 2 \frac{\partial E}{\partial t} \frac{\partial n^2}{\partial t} + E \frac{\partial^2 n^2}{\partial t^2} \right\|$$

برای فرمول بندی ریاضی ساختار نوری لایه های نقص، بلور فوتونی غیرخطی یک-بعدی در حالت بدون نقص در نظر گرفته شده و سپس جملات اختلالی $\Delta^l(z)$ و $\Delta^{nl}(z)$ به آن اضافه شده است، هر دوی جملات غیر تناوبی هستند و در واقع مولفه های خطی و غیرخطی اختلال می باشند. جملات اختلالی به صورت روابط (۲) معرفی می شوند،

$$\Delta^l(z) = \sum_{n=1}^{ND} \Delta^0 \exp[-k^2(z - d_n)^2] \quad (2)$$

$$\Delta^{nl}(z) = \sum_{n=1}^{ND} \Delta^{nl} \exp[-k^2(z - d_n)^2]$$

که d_n و ND به ترتیب تعداد نقص ها و فاصله هر نقص از مرکز ساختار می باشند. عدد صحیح n شماره لایه نقص را مشخص می کند. بنابراین ضریب شکست برای ساختار نوری تناوب مختل شده، به صورت زیر بدست می آید،

$$n(z, |E|^2) = n_{ln} + 2n_{0k} \cos kz + n_{nl}|E|^2 + 2n_{2k}|E|^2 \cos kz + \sum_{n=1}^{ND} (\Delta^0 + \Delta^{nl}|E|^2) \exp[-k^2(z - d_n)^2] \quad (3)$$

که در آن

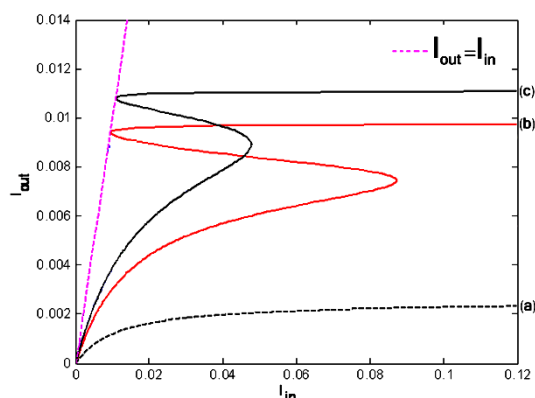
$$n_{ln} = \frac{n_{01} + n_{02}}{2}, \quad n_{nl} = \frac{n_{11} + n_{12}}{2} \quad (4)$$

$$n_{0k} = \frac{n_{01} - n_{02}}{\pi}, \quad n_{2k} = \frac{n_{11} - n_{12}}{\pi}$$

و $k = 2\pi/\Lambda$ عدد موج و Λ طول پریود فضایی ساختار تناوبی می باشد. از اینرو طول کل ساختار $l = N\Lambda$ است. از طرفی نیز می توان $E(z, t)$ را به صورت زیر نوشت،

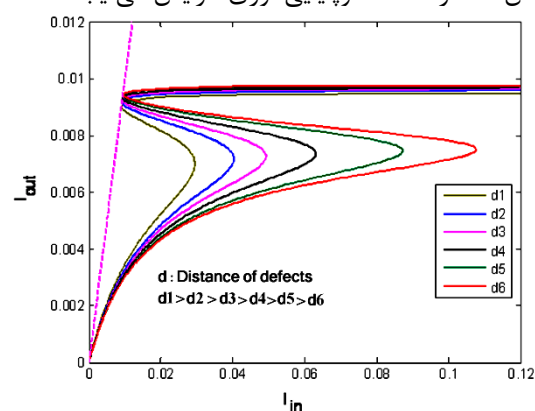
$$E(z, t) = A_+(z, t) \exp[i(k_0 z - \omega_0 t)] + A_-(z, t) \exp[-i(k_0 z + \omega_0 t)] \quad (5)$$

که A_+ و A_- پوش تغییرات آرام امواجی هستند که به ترتیب به سمت جلو و عقب در راستای z حرکت می کنند و $\omega_0 = ck_0/|n_{ln}|$ فرکانس نور فرودی می باشد که داخل باند ممنوعه قرار دارد و $k_0 = 2\pi|n_{ln}|/\lambda$ عدد موج نور است. هنگامی که تغییرات فضایی ساختار پریودیک برای ضریب شکست خطی و غیر خطی کر در مقایسه با متوسط ضریب شکست کوچک باشد یعنی، $|n_{0k}|, |n_{nl}|, |n_{2k}| \ll |n_{ln}|$ معادله موج ماکسول ساده می شود. از طرفی نیز اگر $\lambda = 2|n_{ln}|\Lambda$ ، با استفاده



شکل ۲: اثر تعداد لایه های نقص در تراگیسل (a) بدون لایه نقص (b) با پنج لایه نقص (c) با شش لایه نقص.

شکل ۳ اثر فاصله بین لایه های نقص در ساختار نوری معرفی شده با ۵ لایه نقص را نشان می دهد. بطوریکه با تغییر فاصله بین لایه های نقص، آستانه کلیدزنی دوپایایی نوری قابل تغییر و کنترل می باشد. هر یک از منحنی های تراگیسل در شکل ۳ برای ساختار با ۵ نقص با مقادیر پارامترهای مربوط به شکل ۲ رسم شده است. در شکل (۳) مشاهده می شود که با کاهش فاصله بین لایه های نقص، مقدار آستانه دوپایایی نوری افزایش می یابد.



شکل ۳: اثر فاصله بین لایه های نقص در ساختار نوری شامل ۵ نقص.

شکل ۴ اثر تغییر ضریب شکست خطی لایه های نقص روی منحنی تراگیسل را نشان می دهد. در این شکل از پنج لایه نقص با فواصل $D=4$ در داخل ساختار نوری استفاده شده است. منحنی تراگیسل با مقدار پارامترهای $n_{nl}=0, n_{2k}=1, n_{0k}=0.02, N=35$ محاسبه شده است. مطابق شکل با تغییر ضریب شکست خطی لایه های نقص، آستانه کلیدزنی دوپایایی نوری در منحنی تراگیسل قابل تغییر و تنظیم می باشد.

از تقریب تغییرات آرام پوش یعنی $\left| \frac{\partial A_{\pm}}{\partial z} \right|, \left| \frac{\partial A_{\pm}}{\partial t} \right| \ll |A_{\pm}|$

در نزدیک تشدید، معادلات موج مد کوپل که از معادلات (۱) - (۵) بدست آمده است به راحتی توسط دامنه $A_{\pm}$ برآورد می کند [۵-۶].

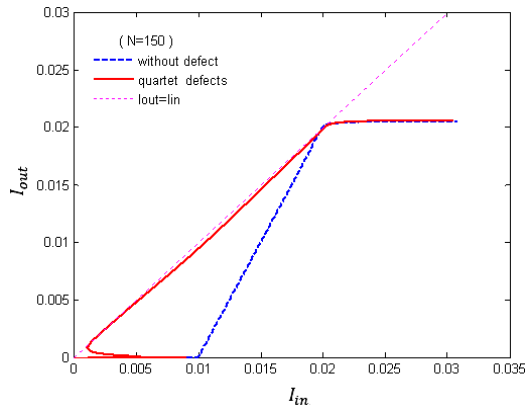
$$i\left(\frac{\partial A_{+}}{\partial Z} + \frac{\partial A_{+}}{\partial T}\right) + n_{0k}A_{-} + \Delta^0 A_{+} \sum_{n=1}^{ND} \exp[-\pi^2(Z-D_n)^2] + (n_{nl} + \Delta^{nl} \sum_{n=1}^{ND} \exp[-\pi^2(Z-D_n)^2])(|A_{+}|^2 + 2|A_{-}|^2)A_{+} + n_{2k}[(2|A_{+}|^2 + |A_{-}|^2)A_{-} + A_{+}^2 A_{-}^*] = 0, \quad (6)$$

$-i\left(\frac{\partial A_{-}}{\partial Z} - \frac{\partial A_{-}}{\partial T}\right) + n_{0k}A_{+} + \Delta^0 A_{-} \sum_{n=1}^{ND} \exp[-\pi^2(Z-D_n)^2] + (n_{nl} + \Delta^{nl} \sum_{n=1}^{ND} \exp[-\pi^2(Z-D_n)^2])(2|A_{+}|^2 + |A_{-}|^2)A_{-} + n_{2k}[(|A_{+}|^2 + 2|A_{-}|^2)A_{+} + A_{+}^* A_{-}^2] = 0,$ که $Z = \omega_0 z / c$ و $T = \omega_0 t / |n_{nl}|$ مختصات زمان و مکان نرمالیزه شده هستند و D_n نیز نرمالیزه شده d_n و به صورت $D_n = \omega_0 d_n / c$ است. در اینجا با استفاده از روش تفاضل محدود، معادلات موج مد کوپل را برای باریکه موج پیوسته که از سمت چپ بر روی ساختار فرود می آید در حالت مانا ($\partial A_{\pm} / \partial T = 0$) حل شده است و منحنی های تراگیسل نور فرودی برای ساختار نوری پیشنهاد شده بدست می آید.

۳- محاسبات عددی و نتایج

در اینجا به بررسی نتایج شبیه سازی آرایش های گوناگون لایه های نقص در بلور فوتونی غیر خطی یک بعدی پرداخته می شود. منحنی های تراگیسل در حالت های بدون حضور و در حضور لایه های نقص شبیه سازی شده است و با یکدیگر مقایسه شده اند. شکل ۲ اثر تعداد لایه های نقص در ساختار نوری را نشان می دهد که منجر به ظهور دوپایایی نوری در منحنی تراگیسل شده است و نشان می دهد که با تغییر تعداد نقص ها، ویژگی های دوپایایی منحنی تراگیسل مانند آستانه کلیدزنی و میزان محدود کنندگی شدت تابش تراگیسل شده قابل تغییر و کنترل خواهد بود. منحنی تراگیسل برای ساختار نوری پیشنهاد شده با مقدار پارامترهای $n_{0k} = -0.02, n_{nl} = 0, n_{2k} = 1, N = 35$ محاسبه شده است. $\Delta^0 = 0.99, \Delta^{nl} = 1, N = 35$

تغییر طول ساختار و مدیریت مکان لایه‌های نقص در ساختار نوری آستانه کلیدزنی قابل تغییر و تنظیم خواهد بود و در نهایت تابش تراگسیل شده را به یک مقدار حدی ($I_{out} = I_{lim}$) محدود می‌کند.



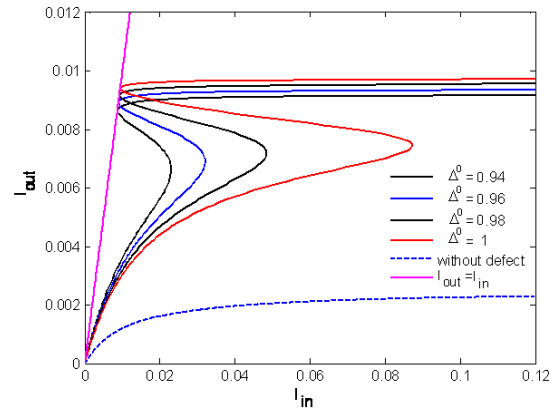
شکل ۶: اثر افزایش طول ساختار تا را بر منحنی تراگسیل.

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله با استفاده از معادله ماکسول غیرخطی، معادلات مد کوپل حاکم بر انتشار نور در ساختار نوری پریودیک یک بعدی با لایه‌های نقص بدست آمده است. با حل عددی معادلات موج مد کوپل در حالت مانا، منحنی-های تراگسیل در حضور آرایش‌های مختلف لایه‌های نقص به دست آمده است. نتایج شبیه سازی حاکی از تغییرات چشمگیر و مناسب برای منحنی تراگسیل با کمک لایه های نقص می باشد. از جمله نتایج قابل ملاحظه می توان به ایجاد و کنترل حالت‌های دوپایا و چندپایا در منحنی‌های تراگسیل اشاره کرد.

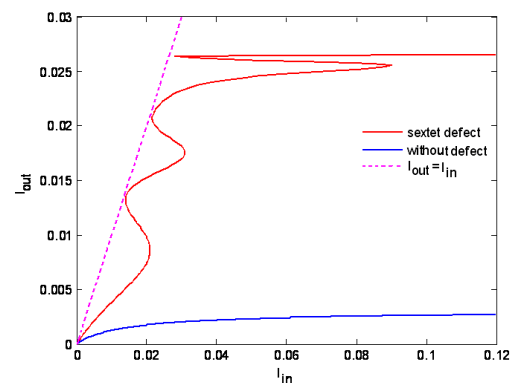
مراجع

- [1] S. Radic, N. George, and G. P. Agrawal, "Theory of Low-threshold optical switching in nonlinear phase-shifted periodic structures," *J. Opt. Soc. Am. B* **12**, 671-680 (1995).
- [2] M. D. Tocci, M. J. Bloemer, M. Scalora, J. P. Dowling, and C. M. Bowden "Thin-film nonlinear optical diode," *Appl. Phys. Lett.* **66**, 2324-2326 (1995).
- [3] C. M. de Sterke and J. E. Sipe, "Gap solitons," *Progress in Optics*, Vol. 33, E. Wolf, eds. (North-Holland, Amsterdam, 1994), Vol. 33 pp. 203-260.
- [4] W. Samir, S.J. Garth, and C. Past, "Interplay of grating and nonlinearity in mode coupling," *J. Opt. Soc. Am. B* **11**, 64-71 (1994).
- [5] D. Pelinovsky, L. Brzozowski, J. Sears, and E. H. Sargent, "Stable All-Optical Limiting in Nonlinear Periodic Structures. I. Analysis" *J. Opt. Soc. Am. B* **19**, 43-53 (2002).
- [6] D. Pelinovsky and E. H. Sargent, "Stable all-optical limiting in nonlinear periodic structures. II. Computations," *J. OptSoc. Am. B* **19**, 1873-1889 (2002).



شکل ۴: اثر ضریب شکست خطی لایه‌های نقص در منحنی تراگسیل.

در شکل ۵ منحنی تراگسیل برای ساختار نوری، با مقدار پارامترهای $\Delta^0 = 2, n_{nl} = 1, n_{2k} = 1, n_{0k} = 0.02, N = 35, \Delta^{nl} = 2$ با شش لایه نقص محاسبه شده است. اثر وجود شش لایه نقص در ساختار نوری منجر به ظهور چندپایایی نوری در منحنی تراگسیل می‌شود.



شکل ۵: اثر حضور ۶ نقص در ساختار نوری و ظهور چند پایایی نوری در منحنی تراگسیل.

شکل ۶ اثر افزایش طول ساختار تا $N = 150$ بر منحنی تراگسیل در حضور یک آرایه نقص چهارتایی را نشان می‌دهد. منحنی تراگسیل برای ساختار نوری پیشنهاد شده با مقدار پارامترهای $n_{0k} = -0.02, n_{2k} = 1, n_{nl} = 0, \Delta^0 = 0.4, \Delta^{nl} = 2$ محاسبه شده است. مطابق شکل ۶ منحنی تراگسیل در حالت بدون نقص به شکل ساده //گویی دو پله‌ای بین مقادیر تراگسیل پایین ($I_{out} = 0$) و تراگسیل بالای محدود به یک مقدار حدی ($I_{out} = I_{lim}$) در آمده است، در حالیکه با اعمال چهار لایه نقص مشاهده می‌شود که الگوی منحنی تراگسیل به شکل مفیدتری تغییر می‌کند. در منحنی تراگسیل جدید خاصیت کلید-زنی بین مقادیر تراگسیل پایین ($I_{out} = 0$) و حالت شفاف ساختار نوری ($I_{out} = I_{in}$) ایجاد می‌شود، بطوریکه با